基本信息



姓名:小泉英明

性别:男

出生日期:1946年10月

当选信息:

2011年 中国工程院

所属学部:

中国工程院

日本工程院

院士简介

小泉英明,男,出生于1946年10月,日本工程院院士,日本学术振兴学会会员,日本工程院外事委员会主任

小泉博士长期从事电子学和成像技术前沿研究,成绩突出,在国际光谱、核磁成像和近红外成像上是国际著名的学者,曾获得诺贝尔奖提名。已注册专利超过163项(日本74项,海外89项),其中50项被日本通产省提名为日本突出专利。

小泉博士多次获得日本的国家级奖励。

2011年当选为中国工程院外籍院士。

主要学历

1967年 - 1971年 日本东京大学 基础科学系 硕士

1971年 - 1976年 日本东京大学 物理学专业 博士

主要经历

1971年 - 2017年 日本日立制作所 副研究员、研究员

1992年 日本日立制作所中央研究实验室医疗电子研究部 首席科学家

1999年 - 2001年 日本日立制作所高级研究实验室 总经理

2003年 日本日立制作所 首席科学家

2004年 - 2017年 日本日立制作所 研究员

2015年 日本工程院 执行副院长

2017年 日本日立制作所 名誉研究员、独立理事

2019年 日本东京大学高级科学技术研究中心 研究员

本资料由中国工程院院士馆提供

